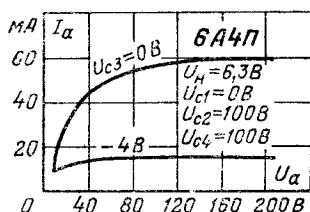
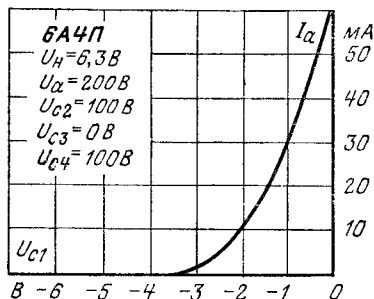


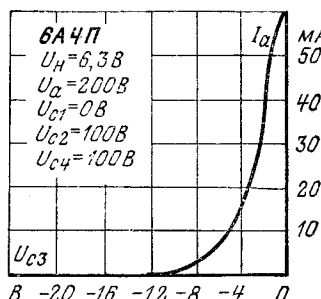
Анодные характеристики при $U_{c3}=0$.



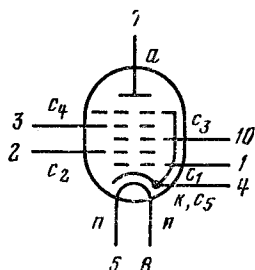
Анодные характеристики при $U_{c1}=0$.



Анодно-сеточная характеристика по 1-й сетке.



Анодно-сеточная характеристика по 3-й сетке.



6A11Г-B

Гептод для преобразования частоты. Оформление — в стеклянной оболочке, сверхминиатюрное (рис. 16Б). Масса 8 г.

Основные параметры

при $U_n=6,3$ В, $U_a=100$ В, $U_{c2}=U_{c4}=100$ В, $U_{c1}=-2$ В, $U_{c3пер}=8,5$ В

Ток накала	(250 ± 25) мА
Ток анода (при $R_{c3}=47$ кОм)	$(3 \pm 1,5)$ мА
Ток 2-й и 4-й сеток (при $R_{c3}=47$ кОм)	≤ 15 мА
Обратный ток 1-й сетки	≤ 1 мкА
Крутизна преобразования (при $U_{c1пер}=0,7$ В)	$0,6-1$ мА/В
То же в начале характеристики (при $U_{c1}=-12$ В)	≥ 10 мкА/В

Продолжение

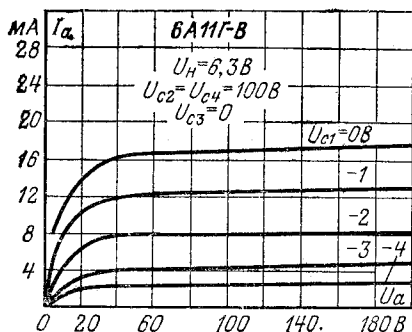
Напряжение виброшумов (при $R_a=2$ кОм)	≤ 150 мВ
Межэлектродные емкости:	
входная по 1-й сетке	6,5 пФ
входная по 3-й сетке	7 пФ
выходная	5 пФ
анод — 1-я сетка	$\leq 0,03$ пФ
анод — 3-я сетка	$\leq 0,04$ пФ
1-я — 3-я сетка	$\leq 0,04$ пФ
катод — подогреватель	≤ 7 пФ
Наработка	≥ 500 ч
Критерии оценки:	
крутизна преобразования	$\geq 0,5$ мА/В
обратный ток 1-й сетки	$\leq 1,5$ мкА
изменение крутизны преобразования	$\leq \pm 35\%$

Предельные эксплуатационные данные

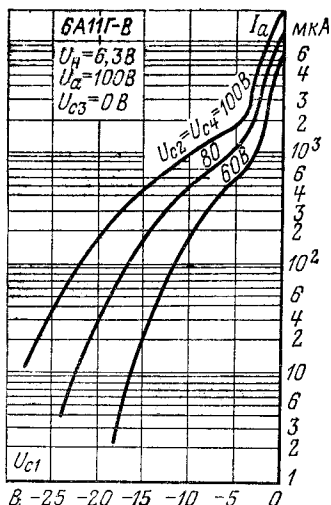
Напряжение накала	5,7—6,9 В
Напряжение анода	150 В
То же при запертой лампе	200 В
Напряжение 2-й и 4-й сеток	100 В
То же при запертой лампе	200 В
Напряжение 1-й сетки (отрицательное)	30 В
Напряжение между катодом и подогревателем	100 В
Ток катода	30 мА
Мощность, рассеиваемая анодом	1,5 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й и 4-й сетками	1,5 Вт
Сопротивление в цепи 1-й сетки	1 МОм
Температура баллона лампы	170 °С

Устойчивость к внешним воздействиям:

ускорение при вибрации в диапазоне частот 10—2000 Гц	10 g
ускорение при многократных ударах	150 g
ускорение при одиночных ударах	500 g
ускорение постоянное	100 g
интервал рабочих температур окружающей среды	От —60 до +200 °С



Анодные характеристики.



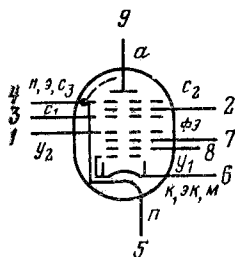
Анодно-сеточные характеристики.

4.8. ГЕПТАГРИДЫ

6Л1П

Гептагрид высокочастотный с разрывно-гистерезисной характеристикой для работы в качестве нелинейного элемента в быстродействующих амплитудных дискриминаторах, бинарных запоминающих и счетных устройствах, ключевых схемах и ограничителях.

Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 14П). Масса 18 г.



Основные параметры

при $U_H=6,3$ В, $U_a=150$ В, $U_{уск1}=U_{уск2}=U_{c2}=150$ В, $U_{c1}=0$, $R_{уск2}=510$ Ом, U_ϕ — оптимальное, подбирается в пределах от 0 до минус 30 В

Ток накала	(320±30) мА
Ток анода	(16,5±3,5) мА
Ток катода	(24±5) мА
Ток 1-го ускорителя	3 мА
Ток 2-го ускорителя (при $U_{c1}=-10$ В)	≤22 мА
Ток 2-й сетки	≤5 мА